

S1ZAS4**40V 1.2A****特長**

- SMD
- PRISMアバランシェ保証

Feature

- SMD
- PRISM Rating

用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

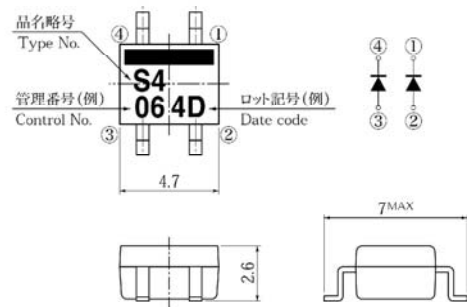
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE

Package : 1Z

Unit:mm

Weight 0.13g (Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)**

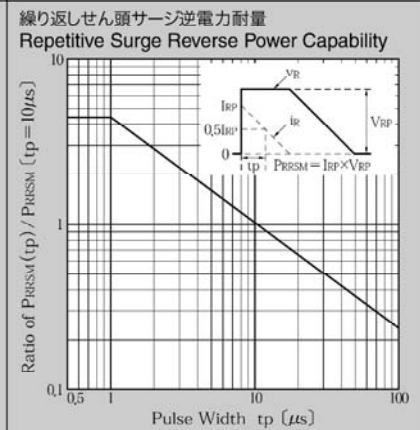
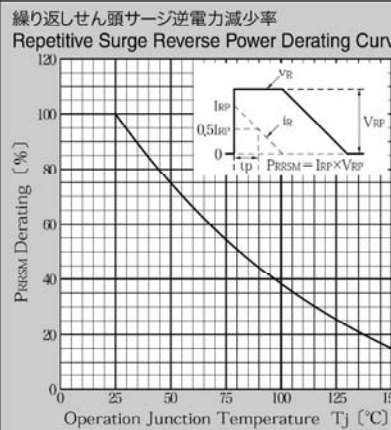
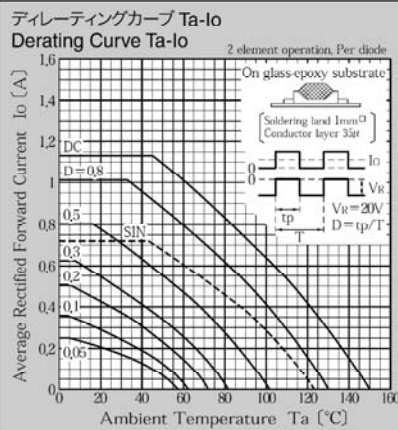
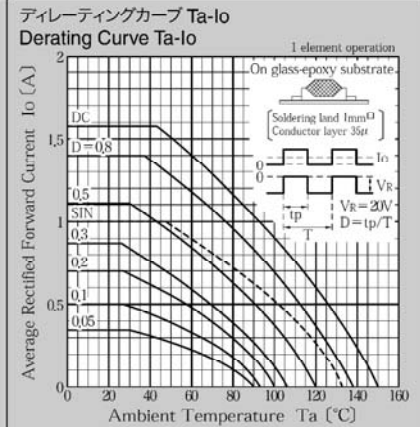
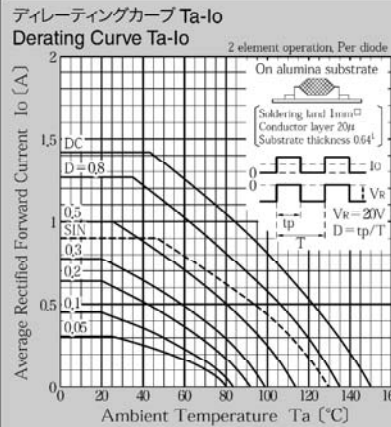
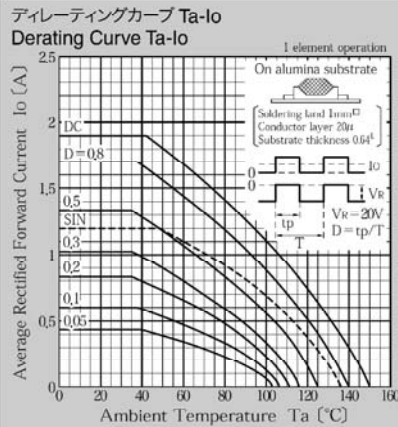
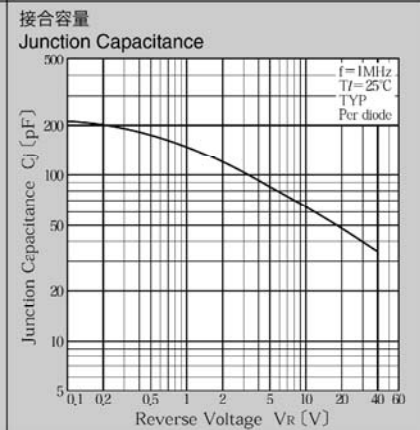
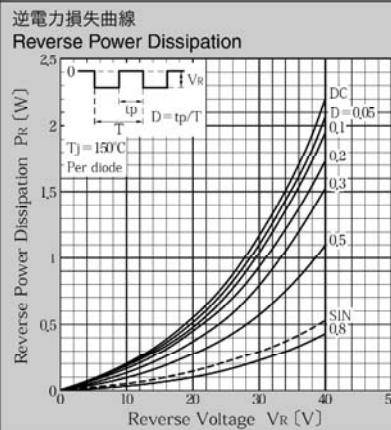
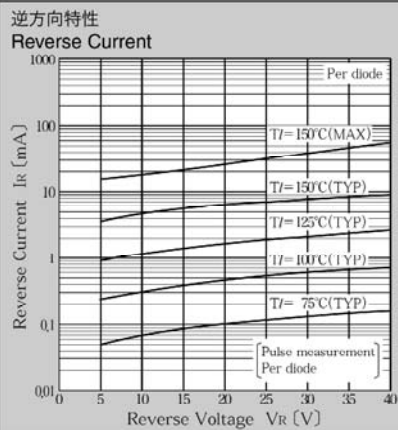
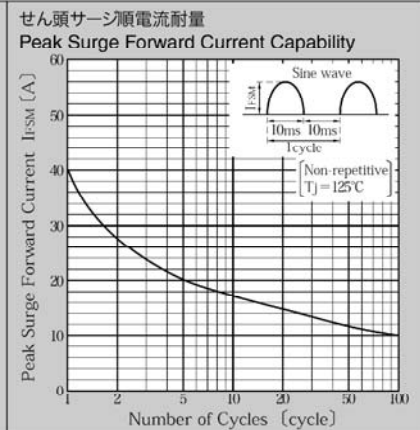
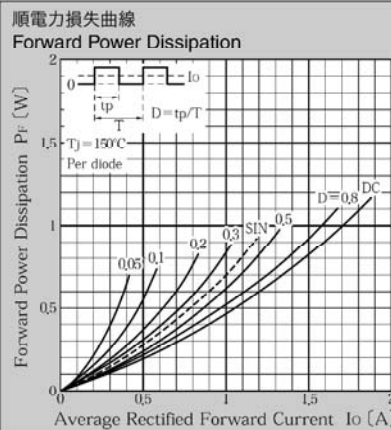
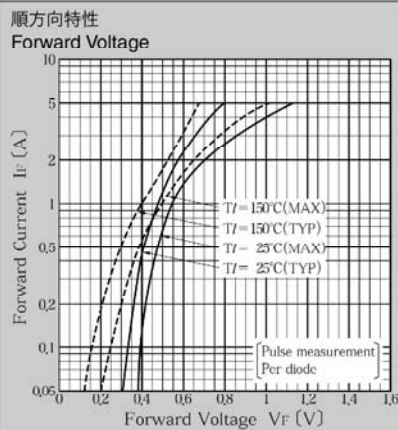
項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	S1ZAS4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg				- 40 ~ 150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj				150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}				40	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40			45	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1 回路通電 Ta = 49℃ 1 element operation	1.2	A
				2 回路通電 Ta = 45℃ 2 element operation	0.9*	
		50Hz sine wave, Resistance load	プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1 回路通電 Ta = 47℃ 1 element operation	1	
				2 回路通電 Ta = 43℃ 2 element operation	0.72*	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1素子当りの規格値, Tj = 125℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Per diode, Tj = 125℃			40	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P _{RRSM}	パルス幅10μs, 1素子当り, Tj = 25℃ Pulse width 10μs, Per diode, Tj = 25℃			60	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 65	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 25	$^\circ\text{C/W}$
	θ_{ja}	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 93
			2回路通電 2 element operation	MAX 140*
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 1 element operation	MAX 120
			2回路通電 2 element operation	MAX 186*

*: 1素子当りの規格値 * : Per diode

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。 Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen:

[S1ZAS4-7102](#) [S1ZAS4-4102](#) [S1ZAS4-7062](#) [S1ZAS4-7072](#) [S1ZAS4-4062](#) [S1ZAS4-4072](#)